

## InnoScience treibt Entwicklung von GaN-Bauelementen mit mehreren MOCVD-Anlagen von AIXTRON voran

AIX G5+ C-Anlage für Massenproduktion ebnet leistungsstarken 650V GaN-on-Si<sup>1</sup>-Bauelementen den Weg

**Herzogenrath, 21. November 2018** – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein weltweit führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, wird mehrere AIX G5+ C MOCVD-Anlagen an InnoScience Technology Co. Ltd. (China) für die Entwicklung von GaN-(Galliumnitrid)-Leistungsbauelementen liefern, die aufgrund ihrer überlegenen Leistung bei hohen Frequenzen in verschiedenen Anwendungen zunehmend die Si-(Silizium)-Leistungsbauelemente verdrängen. Alle Anlagen-Cluster von AIXTRON sind mit einer 5x200 mm Konfiguration ausgestattet und werden bis Q2/2019 ausgeliefert.

GaN-Leistungsbauelemente haben im Vergleich zu den herkömmlichen Si-basierten Leistungsbauelementen sehr niedrige Leitungs-, Schalt- und Ausschaltverluste, da sie eine höhere Durchschlagsfestigkeit, Schaltgeschwindigkeit und Wärmeleitfähigkeit sowie einen geringeren On-Widerstand aufweisen. GaN-Leistungsbauelemente kommen bereits heute in Anwendungen wie der effizienten Stromversorgung für PC und Server oder der optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung (*Light Detection And Ranging, LiDAR*) sowie der drahtlosen Leistungsübertragung, die ein schnelles Umschalten über 1 MHz erfordern, zum Einsatz. Darüber hinaus haben sie auch Vorteile bei der Anwendung in Elektrofahrzeugen wie On-Board-Ladegeräten (OBC), da sie die Systemgröße durch überlegene thermische Eigenschaften und die Reduzierung der passiven Komponenten deutlich reduzieren.

Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Zahl von Anwendungen kann die AIX G5+ C-Anlage von AIXTRON ihre Vorteile im Herstellungsprozess voll ausspielen, da die Anlage skalierbare Prozesse, strenge Gleichmäßigkeit und Partikelkontrolle der epitaktischen Wafer ermöglicht, um höchste Ausbeute und maximalen Durchsatz bei niedrigsten Betriebskosten zu ermöglichen.

Jay Son, CEO von InnoScience Technology, sagt: "Wir haben uns für die AIX G5+ C entschieden, da sie aufgrund der hervorragenden Eigenschaften des Planetenreaktor-Konzepts eine ausgezeichnete Dicke und Gleichmäßigkeit der Wafer liefert. Die neu erworbenen Anlagen werden uns eine Produktionssteigerung für unsere Spitzenprodukte wie die 650V GaN-on-Si-Bauelemente zu den besten Stückkosten pro Wafer auf dem Markt ermöglichen."

"Die Marktnachfrage nach Leistungselektronik, insbesondere nach GaN-basierten Bauelementen, nimmt zu und AIXTRON verfügt mit der AIX G5+ C über die leistungsfähigste Anlage im Markt. Wir freuen uns, dass InnoScience in China voranschreitet und sich für diese Anlage entschieden hat, die nicht nur durch ihre Leistung überzeugt, sondern auch die

---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL [info@aixtron.com](mailto:info@aixtron.com) WEB [www.aixtron.com](http://www.aixtron.com)

Produktion von GaN-Leistungsbaulementen wirtschaftlich rentabel macht", sagt Dr. Felix Grawert, Vorstand der AIXTRON SE.

<sup>1</sup> GaN-on-Si = Galliumnitrid-auf-Silizium

## Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT<sup>®</sup>, AIXTRON<sup>®</sup>, APEVA<sup>®</sup>, Atomic Level SolutionS<sup>®</sup>, Close Coupled Showerhead<sup>®</sup>, CRIUS<sup>®</sup>, EXP<sup>®</sup>, EPISON<sup>®</sup>, Gas Foil Rotation<sup>®</sup>, Optacap<sup>™</sup>, OVPD<sup>®</sup>, Planetary Reactor<sup>®</sup>, PVPD<sup>®</sup>, STExS<sup>®</sup>, TriJet<sup>®</sup>

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter [www.aixtron.com](http://www.aixtron.com) verfügbar.

## Über InnoScience

InnoScience Technology Co. Ltd. wurde im Dezember 2015 von Wissenschaftlern und Experten aus den USA, Korea, Taiwan und China gegründet. InnoScience widmet sich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Halbleitern mit großer Bandlücke („wide-bandgap semiconductors“). Die erste Fabrik des Unternehmens befindet sich im Zhuhai National Hi-Tech District (China). InnoScience hat Chinas erste Massenproduktionslinie von 8-Zoll-E-Mode GaN-on-Si-Leistungsbaulementen etabliert. Zu den Schlüsselprodukten gehören 30V-650V GaN-on-Si-Leistungsbaulemente. Das Design und die Leistungsfähigkeit des Produkts haben das weltweit höchste Niveau erreicht. InnoScience strebt den Aufbau eines weltweit führenden Unternehmens für Leistungsbaulemente in China an und engagiert sich für die chinesische Halbleiterindustrie.

## Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind.. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL [info@aixtron.com](mailto:info@aixtron.com) WEB [www.aixtron.com](http://www.aixtron.com)